

5A, 700V 超结 MOS功率管

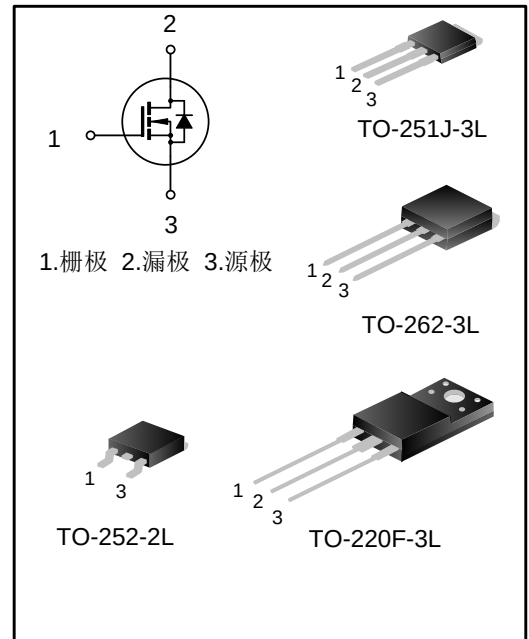
描述

SVS5N70F(D)(MJ)(K)D2 N 沟道增强型高压功率 MOSFET 采用士兰微电子超结 MOS 技术平台制造，具有很低的传导损耗和开关损耗。使得功率转换器具有高效，高功率密度，提高热行为。

此外，SVS5N70F(D)(MJ)(K)D2 应用广泛。如，适用于硬/软开关拓扑。

特点

- ◆ 5A, 700V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= $0.8\Omega@V_{GS}=10V$
- ◆ 创新高压技术
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 定期额定雪崩
- ◆ 较强 dv/dt 能力
- ◆ 高电流峰值



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVS5N70FD2	TO-220F-3L	5N70FD2	无卤	料管
SVS5N70DD2TR	TO-252-2L	5N70DD2	无卤	编带
SVS5N70MJD2	TO-251J-3L	5N70MJD2	无卤	料管
SVS5N70KD2	TO-262-3L	SVS5N70KD2	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数		符号	参数值			单位
			SVS5N70FD2	SVS5N70DD2/MJD2	SVS5N70KD2	
漏源电压		V _{DS}	700			V
栅源电压		V _{GS}	±30			V
漏极电流	T _C =25°C	I _D	5.0			A
	T _C =100°C		3.2			
漏极脉冲电流		I _{DM}	18			A
耗散功率(T _C =25°C) - 大于25°C每摄氏度减少		P _D	31	52	89	W
			0.2	0.35	0.71	W/°C
单脉冲雪崩能量（注 1）		E _{AS}	301			mJ
反向二极管 dv/dt（注 2）		dv/dt	15			V/ns
MOS管 dv/dt 耐用性（注 3）		dv/dt	50			V/ns
工作结温范围		T _J	-55~+150			°C
贮存温度范围		T _{stg}	-55~+150			°C

热阻特性

参数		符号	参数值			单位
			SVS5N70FD2	SVS5N70DD2/MJD2	SVS5N70KD2	
芯片对管壳热阻		$R_{\theta JC}$	4.1	2.4	1.4	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻		$R_{\theta JA}$	62.5	62.0	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

电气参数(除非特殊说明, $T_J=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	700	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=700V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
静态漏源导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=2.5A$	--	0.8	0.9	Ω
栅电阻	R_g	$f=1MHz$	--	6.0	--	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0MHz$	--	334	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	20	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	1.8	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=350V, I_D=5.0A,$ $V_{GS}=10V, R_G=24\Omega$ (注 4, 5)	--	8.3	--	ns
开启上升时间	t_r		--	25	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	35	--	
关断下降时间	t_f		--	24	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=560V, I_D=5.0A,$ $V_{GS}=10V$ (注 4, 5)	--	13	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	2.9	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	7.0	--	

源-漏二极管特性参数

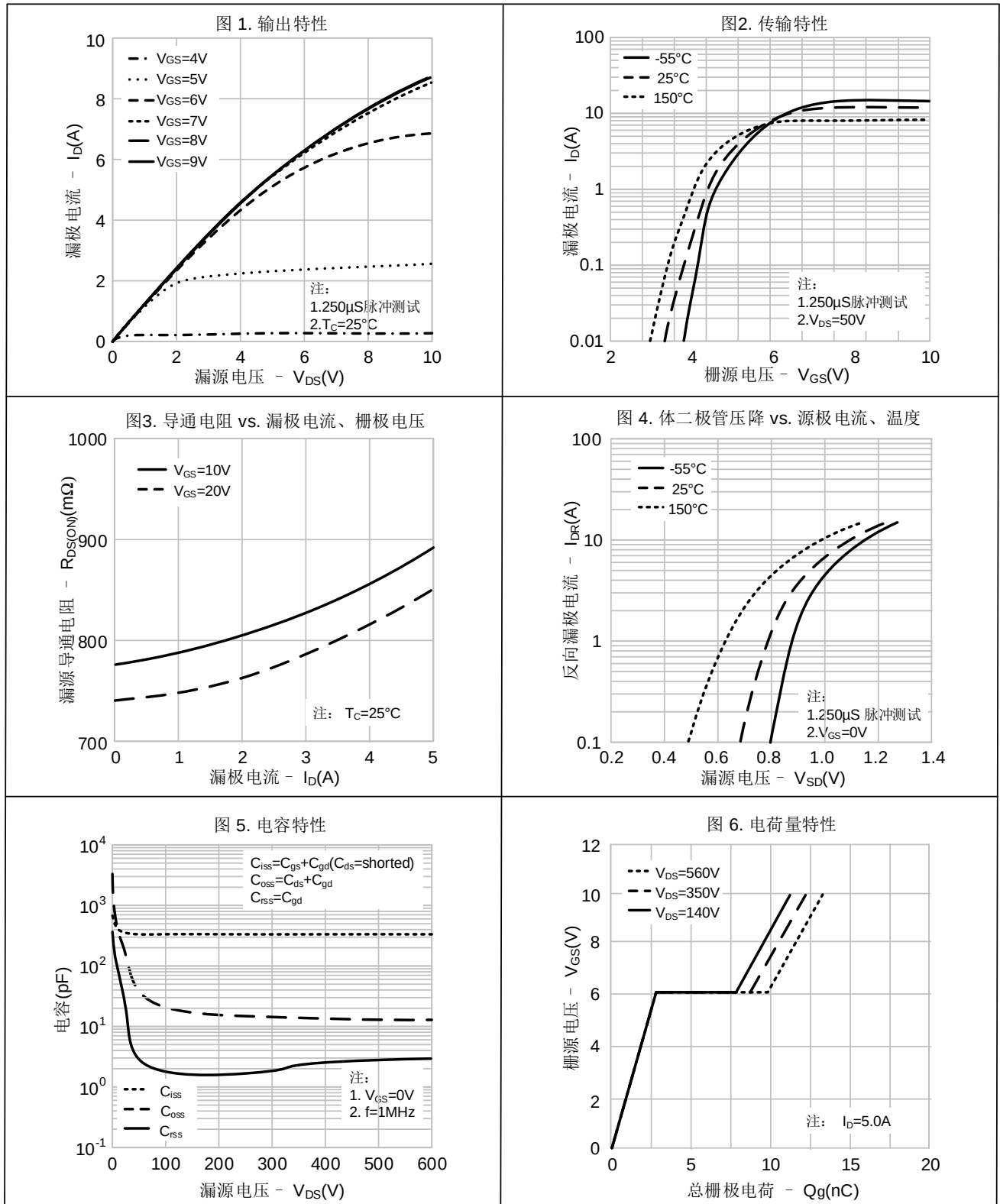
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
连续源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的 反偏 P-N 结	--	--	5.0	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	18	
二极管压降	V_{SD}	$I_S=5.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=5.0A, V_{GS}=0V,$ $dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 4)	--	302	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	2.0	--	μC

注:

1. $L=79mH, I_{AS}=2.6A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^{\circ}\text{C}$;
2. $V_{DS}=0\sim 400V, I_{SD}\leq 5A, T_J=25^{\circ}\text{C}$;
3. $V_{DS}=0\sim 480V$;
4. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
5. 基本上不受工作温度的影响。



典型特性曲线





典型特性曲线(续)

图7. 击穿电压vs.温度特性

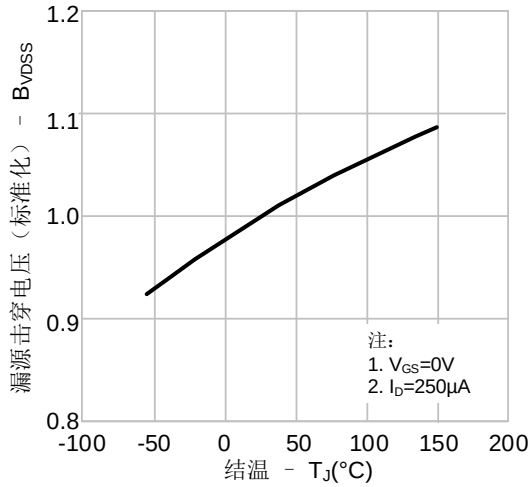


图8. 导通电阻vs.温度特性

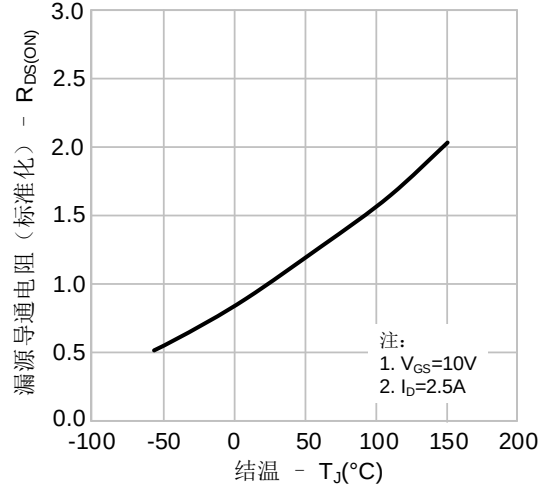


图 9-1. 最大安全工作区域(SVS5N70DD2/MJD2)

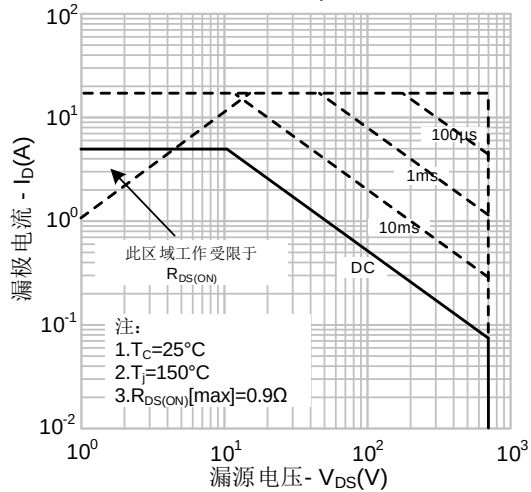


图 9-2. 最大安全工作区域(SVS5N70FD2)

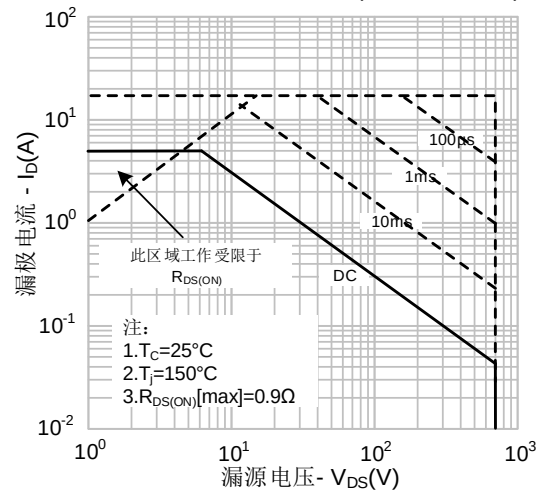
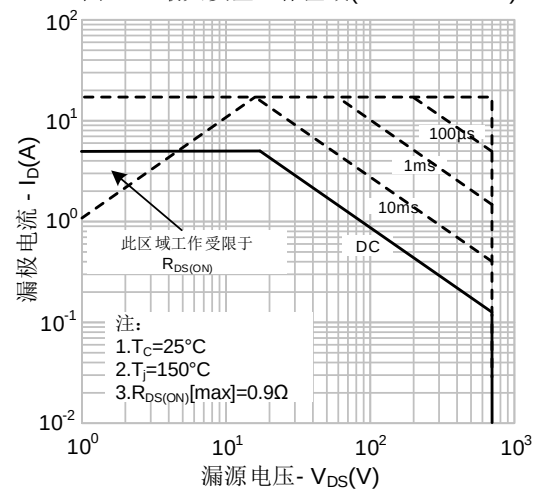
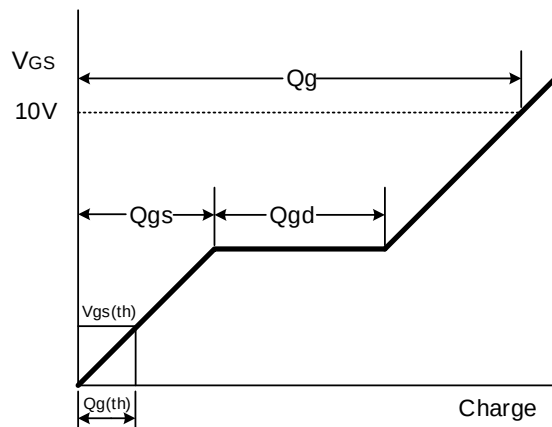
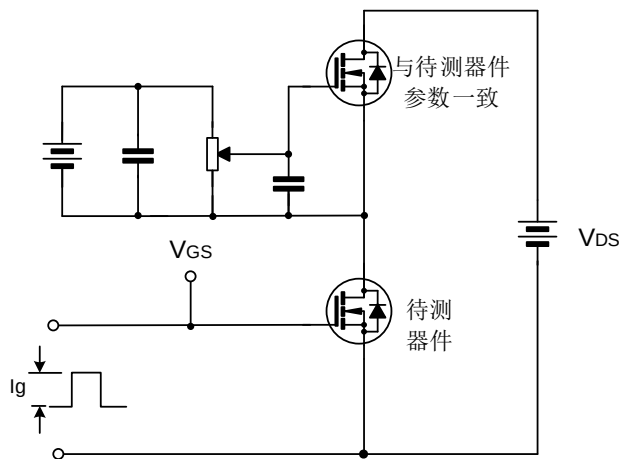


图 9-3. 最大安全工作区域(SVS5N70KD2)

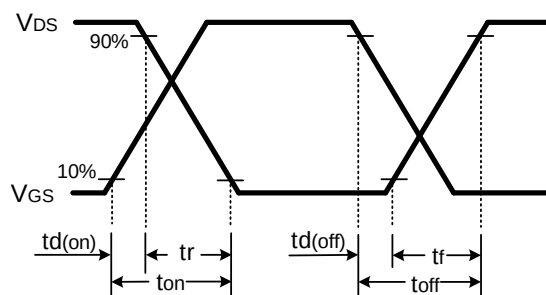
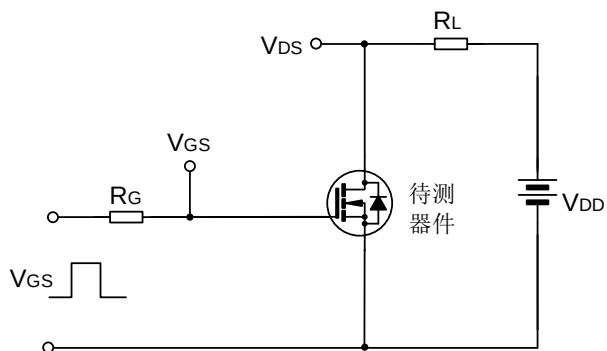


典型测试电路

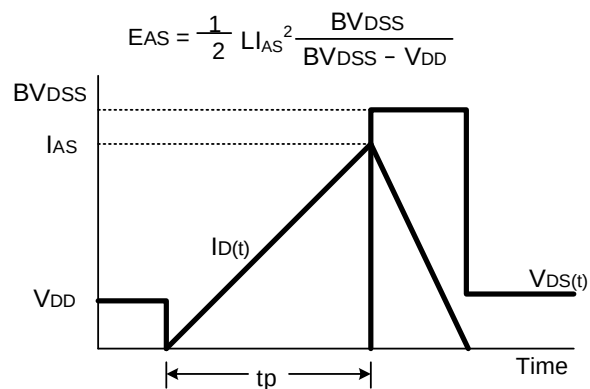
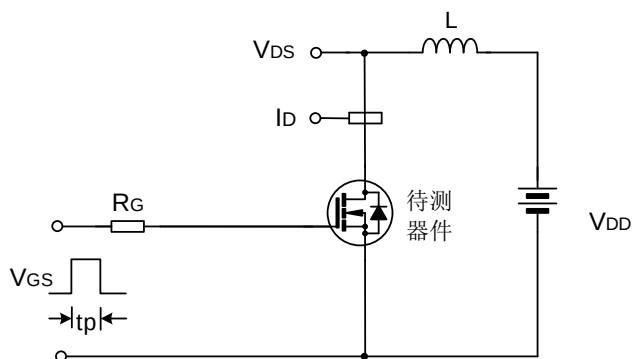
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



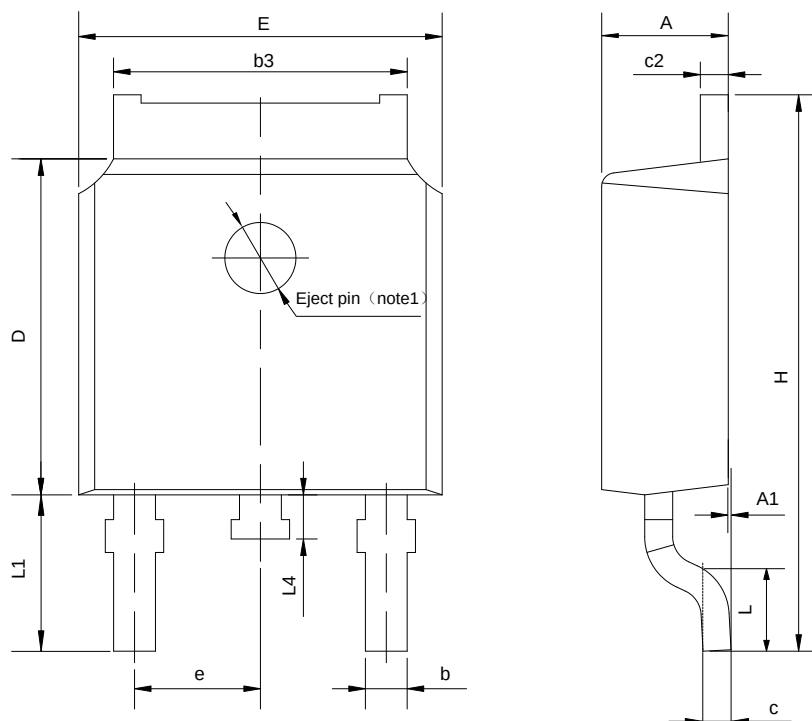
EAS测试电路及波形图



封装外形图

TO-252-2L

单位:毫米

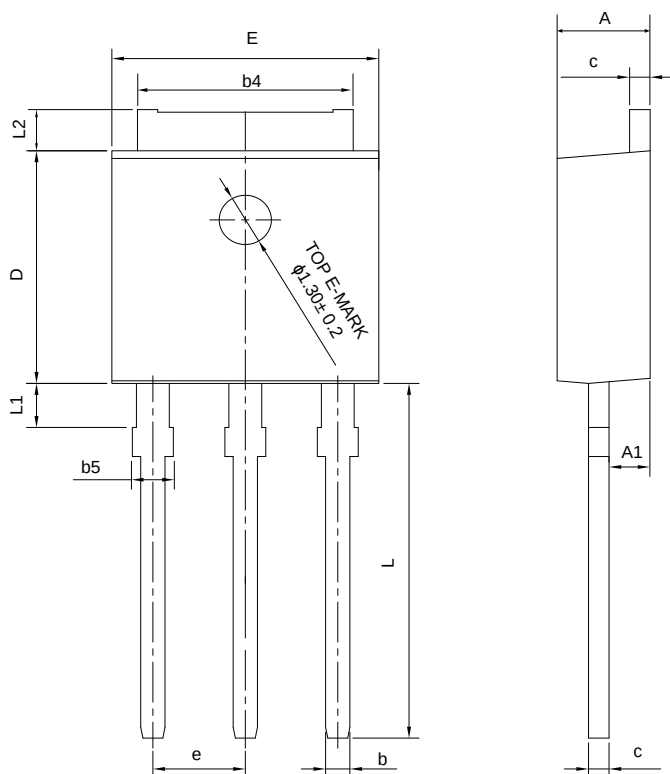


NOTE1 : There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	2.10	2.30	2.50
A1	0	—	0.127
b	0.66	0.76	0.89
b3	5.10	5.33	5.46
c	0.45	—	0.65
c2	0.45	—	0.65
D	5.80	6.10	6.40
E	6.30	6.60	6.90
e	2.30TYP		
H	9.60	10.10	10.60
L	1.40	1.50	1.70
L1	2.90REF		
L4	0.60	0.80	1.00

TO-251J-3L

单位:毫米

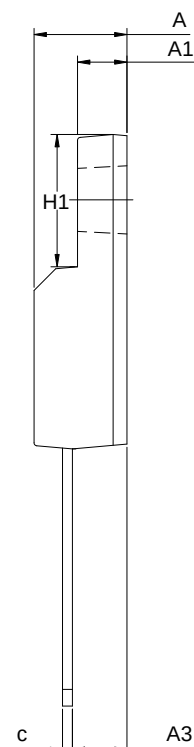
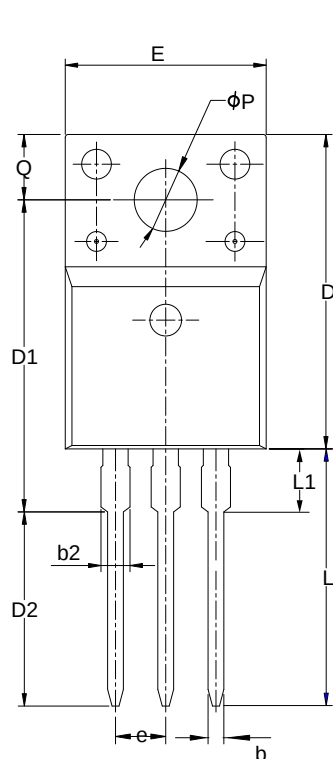


SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	2.18	2.30	2.39
A1	0.89	1.00	1.14
b	0.56	—	0.89
b4	4.95	5.33	5.46
b5	—	—	1.05
c	0.46	—	0.61
D	5.97	6.10	6.27
E	6.35	6.60	6.73
e	2.29 BCS		
L	8.89	9.30	9.65
L1	0.95	—	1.50
L2	0.89	—	1.27

封装外形图(续)

TO-220F-3L

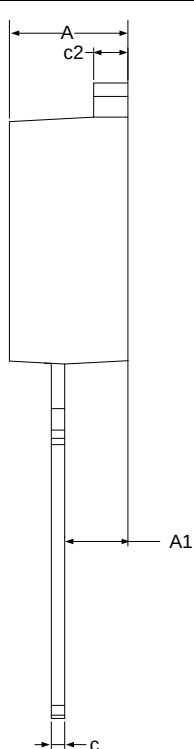
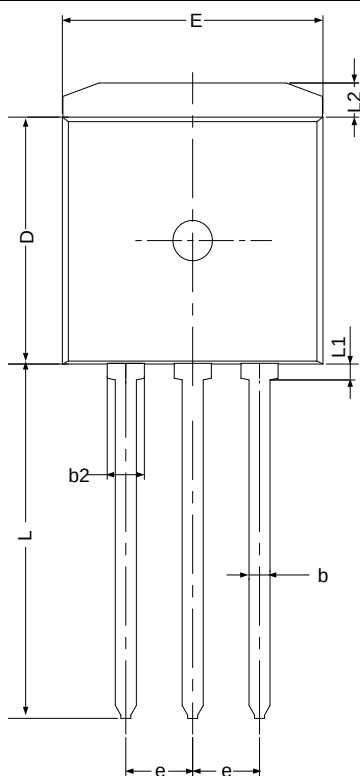
单位:毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BSC		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	3.50
phi P	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

TO-262-3L

单位:毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.50	4.70
A1	2.20	—	2.92
b	0.71	0.80	0.90
b2	1.20	—	1.50
c	0.34	—	0.65
c2	1.22	1.30	1.35
D	8.38	—	9.30
E	9.80	10.16	10.54
e	2.54 BSC		
L	12.80	—	14.10
L1	—	—	0.75
L2	1.12	—	1.42

重要注意事项：

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称：	SVS5N70F(D)(MJ)(K)D2	文档类型：	说明书
版 权：	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页：	http://www.silan.com.cn

版 本： 1.2

修改记录：

1. 添加(TO-262-3L)封装
2. 更新重要注意事项

版 本： 1.1

修改记录：

1. 更新电气图和典型电路图
2. 更新电容曲线

版 本： 1.0

修改记录：

1. 正式版本发布